

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
В СХЕМАХ.

ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

ГОСТ
2.730-73
(СТ СЭВ 661-77)

Unified system for design documentation.
Graphical symbols in diagrams.
Semiconductor devices






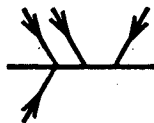


Дата введения 01.07.74








1. Настоящий стандарт устанавливает правила построения условных графических обозначений полупроводниковых приборов на схемах, выполняемых вручную или автоматическим способом во всех отраслях промышленности.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 661-77.






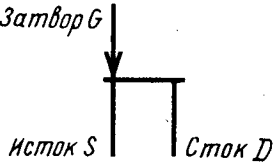
2. Обозначения элементов полупроводниковых приборов приведены в табл. 1.

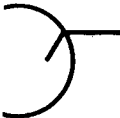



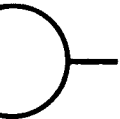
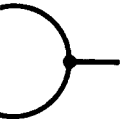
Таблица 1

Наименование	Обозначение
1. (Исключен, Изм. № 2).	
2. Электроды:	
база с одним выводом	
база с двумя выводами	 или 
<i>P</i> -эмиттер с <i>N</i> -областью	
<i>N</i> -эмиттер с <i>P</i> -областью	
несколько эмиттеров, например, четыре <i>P</i> -эмиттера с <i>N</i> -областью	
коллектор с базой	
несколько коллекторов, например, четыре коллектора на базе	

Наименование	Обозначение
3. Области:	
<p>область между проводниковыми слоями с различной электропроводностью.</p>	
<p>Переход от <i>P</i>-области к <i>N</i>-области и наоборот</p>	
<p>область собственной электропроводности (<i>I</i>-область):</p>	
<p>1) между областями с электропроводностью разного типа <i>PIN</i> или <i>NIP</i></p>	
<p>2) между областями с электропроводностью одного типа <i>PIP</i> или <i>NIN</i></p>	
<p>3) между коллектором и областью с противоположной электропроводностью <i>PIN</i> или <i>NIP</i></p>	
<p>4) между коллектором и областью с электропроводностью того же типа <i>PIP</i> или <i>NIN</i></p>	
<p>4. Канал проводимости для полевых транзисторов:</p> <p>обогащенного типа</p>	
<p>обедненного типа</p>	

Продолжение табл. 1

Наименование	Обозначение
5. Переход <i>PN</i>	
6. Переход <i>NP</i>	
7. <i>P</i> -канал на подложке <i>N</i> -типа, обогащенный тип	
8. <i>N</i> -канал на подложке <i>P</i> -типа, обедненный тип	
9. Затвор изолированный	
10. Исток и сток	


Наименование	Обозначение
11. Выводы полупроводниковых приборов:	
электрически не соединенные с корпусом	 или 
электрически соединенные с корпусом	 или 
12. Вывод корпуса внешний. Допускается в месте присоединения к корпусу помещать точку	 или 




(Измененная редакция, Изм. № 2).

3, 4. (Исключены, Изм. № 1).

5. Знаки, характеризующие физические свойства полупроводниковых приборов, приведены в табл. 4.

Таблица 4




Наименование	Обозначение
1. Эффект туннельный а) прямой	





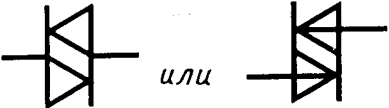
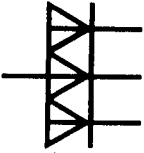
Наименование	Обозначение
б) обращенный	
2. Эффект лавинного пробоя: а) односторонний	
б) двухсторонний	


3-8. (Исключены, Изм. № 2).

6. Примеры построения обозначений полупроводниковых диодов приведены в табл. 5.

Таблица 5





Наименование	Обозначение
1. Диод Общее обозначение	
2. Диод туннельный	
3. Диод обращенный	

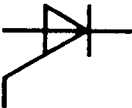

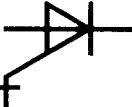
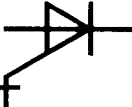
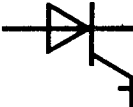
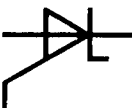
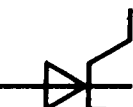
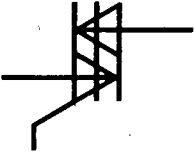
Наименование	Обозначение
4. Стабилитрон (диод лавинный выпрямительный)	
а) односторонний	
б) двухсторонний	
5. Диод теплоэлектрический	
6. Варикап	
7. Диод двунаправленный	
8. Модуль с несколькими (например, тремя) одинаковыми диодами с общим анодным и самостоятельными катодными выводами	

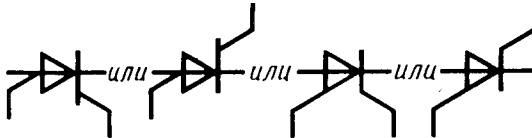
Наименование	Обозначение
9. Диод Шоттки	

7. Обозначения тиристоров приведены в табл. 6.

Таблица 6

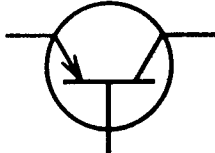
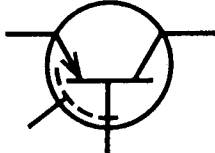
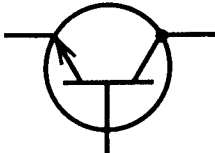
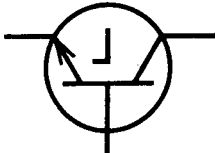
Наименование	Обозначение
1. Тиристор диодный, запираемый в обратном направлении	
2. Тиристор диодный, проводящий в обратном направлении	
3. Тиристор диодный симметричный	
4. Тиристор триодный. Общее обозначение	

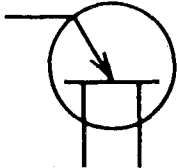
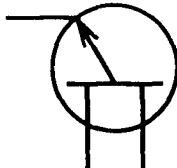
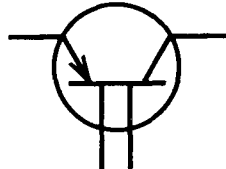
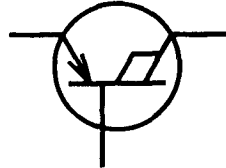
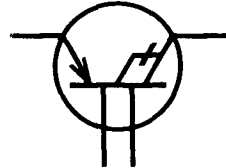
Наименование	Обозначение
5. Тиристор триодный, запираемый в обратном направлении с управлением:	
по аноду	
по катоду	
6. Тиристор триодный, запираемый в обратном направлении, выключаемый, с управлением:	<p style="text-align: center;"><i>или</i></p> 
по аноду	
по катоду	<p style="text-align: center;"><i>или</i></p> 
7. Тиристор триодный, проводящий в обратном направлении, с управлением:	
по аноду	
по катоду	<p style="text-align: center;"><i>или</i></p> 
8. Тиристор триодный симметричный (двунаправленный)	

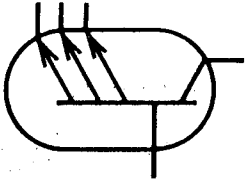
Наименование	Обозначение
9. Тиристор тетродный, запираемый в обратном направлении	

8. Примеры построения обозначений транзисторов с $P-N$ -переходами приведены в табл. 7.

Таблица 7

Наименование	Обозначение
1. Транзистор: а) типа PNP	
б) типа PNP с выводом от внутреннего экрана	
2. Транзистор типа NPN с коллектором, электрически соединенным с корпусом	
3. Лавинный транзистор типа NPN	

Наименование	Обозначение
4. Транзистор однопереходный с <i>N</i> -базой	
5. Транзистор однопереходный с <i>P</i> -базой	
6. Транзистор типа <i>PNP</i> с двумя базовыми выводами	
7. Транзистор типа <i>PNIP</i>	
8. Транзистор типа <i>PNIN</i> с выводом от <i>i</i> -области	

Наименование	Обозначение
9. Транзистор многоэмиттерный типа <i>NPN</i>	

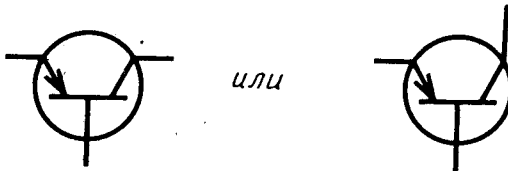
Примечание. Для упрощения на схемах допускается:

а) выполнять обозначения транзисторов в зеркальном изображении, например:



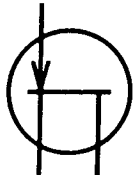
б) не изображать корпус, если смысл обозначения не меняется и корпус не используется для электрического подключения;

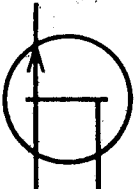

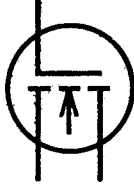
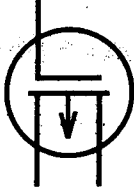
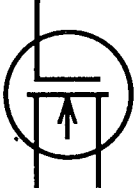
в) проводить линию электрической связи от эмиттера или коллектора в одном из двух направлений: перпендикулярно или параллельно линии вывода базы.

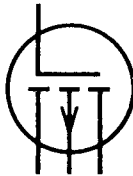
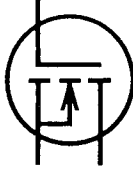
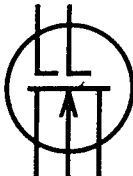


9. Примеры построения обозначений полевых транзисторов приведены в табл. 8.

Таблица 8

Наименование	Обозначение
1. Транзистор полевой с каналом <i>N</i> -типа	

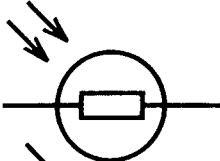
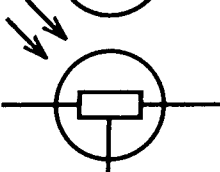
Наименование	Обозначение
2. Транзистор полевой с каналом <i>P</i> -типа	
3. Транзистор полевой с изолированным затвором:	
а) обогащенного типа с <i>P</i> -каналом	
б) обогащенного типа с <i>N</i> -каналом	
в) обедненного типа с <i>P</i> -каналом	
г) обедненного типа с <i>N</i> -каналом	

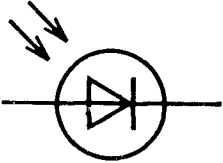
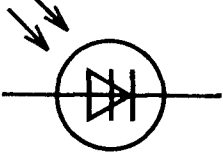
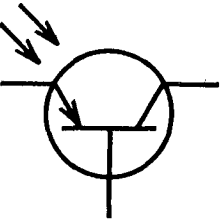
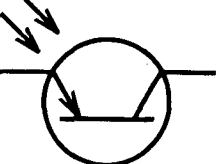
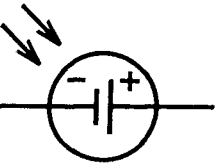
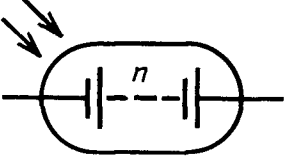
Наименование	Обозначение
4. Транзистор полевой с изолированным затвором обогащенного типа с <i>P</i> -каналом с выводом от подложки	
5. Транзистор полевой с изолированным затвором обогащенного типа с <i>N</i> -каналом и с внутренним соединением подложки и истока	
6. Транзистор полевой с двумя изолированными затворами обедненного типа с <i>N</i> -каналом и с выводом от подложки	

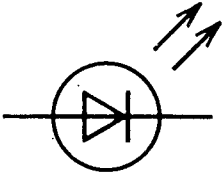
Пр и м е ч а н и е. Изображение окружности является обязательным.

10. Примеры построений обозначений фоточувствительных и излучающих полупроводниковых приборов приведены в табл. 9.

Таблица 9

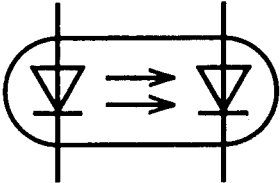
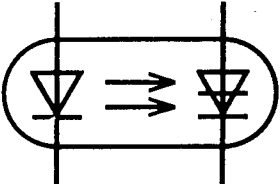
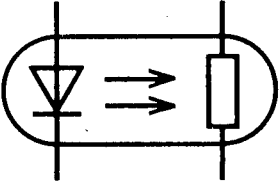
Наименование	Обозначение
1. Фоторезистор: а) общее обозначение	
б) дифференциальный	

Наименование	Обозначение
2. Фотодиод	
3. Фототиристор диодный	
4. Фототранзистор типа PNP:	
а) общее обозначение	
б) база не выведена	
5. Фотоэлемент солнечный	
Примечание. Допускается знаки полярности не указывать	
6. Фотобатарея солнечная (n солнечных элементов)	

Наименование	Обозначение
7. Светодиод	

11. Примеры построения обозначений оптоэлектронных приборов приведены в табл. 10.

Таблица 10

Наименование	Обозначение
1. Оптрон диодный	
2. Оптрон тиристорный	
3. Оптрон резисторный	

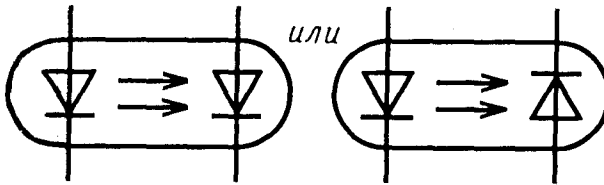
Наименование	Обозначение
4. Оптрон диодный с усилителем, изображенный:	
а) совмещенно	<p style="text-align: center;"><i>или</i></p>
б) разнесенно	
5. Прибор оптоэлектронный с фототранзистором:	
а) с выводом от базы	
б) без вывода от базы	

Примечания:

1. Допускается изображать оптоэлектронные приборы разнесенным способом. При этом знак оптического взаимодействия должен быть заменен знаками оптического излучения и поглощения в соответствии с требованиями табл. 4, например:



2. Взаимная ориентация обозначений источника и приемника не устанавливается, а определяется удобством вычерчивания схемы, например:

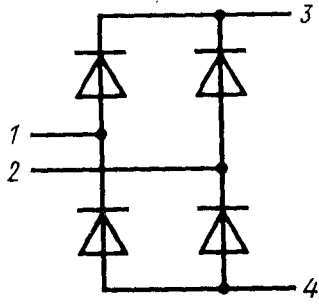
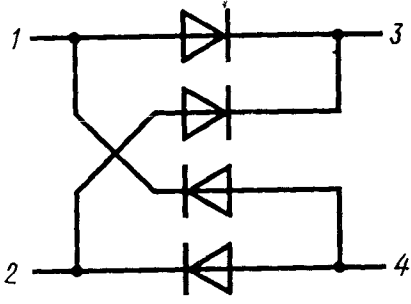
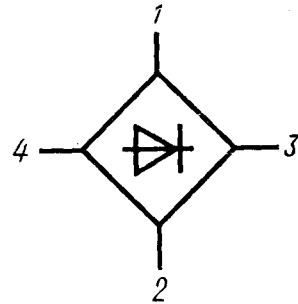


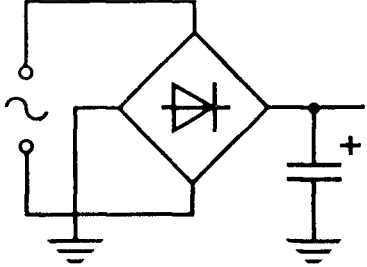
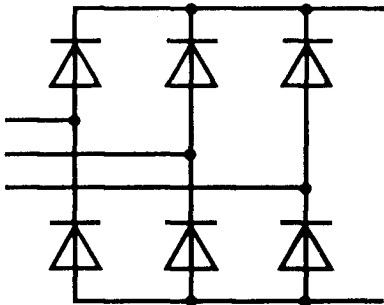
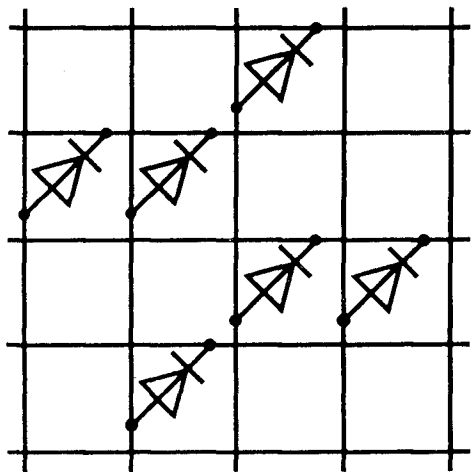
12. Примеры построения обозначений прочих полупроводниковых приборов приведены в табл. 11.

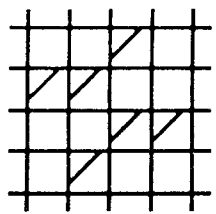
Таблица 11

Наименование	Обозначение
<p>I. Датчик Холла</p> <p>Токовые выводы датчика изображены линиями, отходящими от коротких сторон прямоугольника</p>	

13. Примеры изображения типовых схем на полупроводниковых диодах приведены в табл. 12.

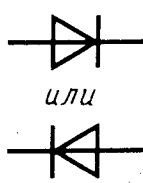
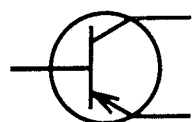
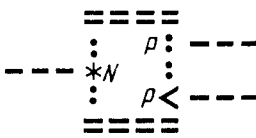
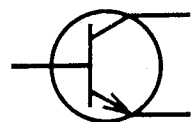
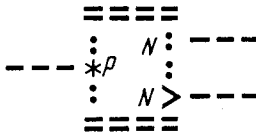
Наименование	Обозначение
<p>1. Однофазная мостовая выпрямительная схема:</p> <p>а) развернутое изображение</p>	 <p style="text-align: center;"><i>или</i></p> 
<p>б) упрощенное изображение (условное графическое обозначение)</p> <p>Примечание. К выводам 1-2 подключается напряжение переменного тока; выводы 3-4 - выпрямленное напряжение; вывод 3 имеет положительную полярность.</p> <p>Цифры 1, 2, 3 и 4 указаны для пояснения.</p>	

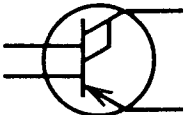
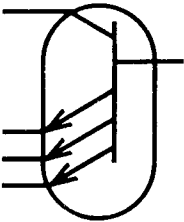
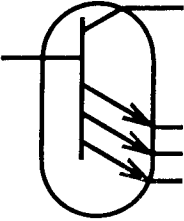
Наименование	Обозначение
<p>Пример применения условного графического обозначения на схеме</p>	 <p>The diagram shows a diamond-shaped diode bridge rectifier. The top-left input is connected to an AC source symbol (a sine wave). The bottom-left input is connected to a ground symbol. The right-side output is connected to a DC load, represented by a battery symbol with a '+' sign, which is also connected to a ground symbol.</p>
<p>2. Трехфазная мостовая выпрямительная схема</p>	 <p>The diagram shows a three-phase bridge rectifier. It consists of six diodes arranged in two columns of three. The left column has three diodes with their cathodes connected to three separate AC input lines. The right column has three diodes with their anodes connected to the same three AC input lines. The top and bottom nodes of the bridge are connected to a common DC output line, while the middle nodes are connected to another common DC output line.</p>
<p>3. Диодная матрица (фрагмент)</p>	 <p>The diagram shows a 5x5 grid of lines. Five diodes are placed on the grid, each with one terminal at a grid intersection and the other terminal at an adjacent intersection. The diodes are oriented as follows: one from (row 2, col 1) to (row 1, col 2); one from (row 3, col 2) to (row 2, col 3); one from (row 4, col 3) to (row 3, col 4); one from (row 5, col 4) to (row 4, col 5); and one from (row 1, col 5) to (row 2, col 4).</p>

Наименование	Обозначение
<p>Примечание. Если все диоды в узлах матрицы включены идентично, то допускается применять упрощенный способ изображения. При этом на схеме должны быть приведены пояснения о способе включения диодов</p>	

14. Условные графические обозначения полупроводниковых приборов для схем, выполнение которых при помощи печатающих устройств ЭВМ предусмотрено стандартами Единой системы конструкторской документации, приведены в табл. 13.

Таблица 13

Наименование	Обозначение	Отпечатанное обозначение
1. Диод	 <p style="text-align: center;">или</p>	<p style="text-align: center;">--- + > ---</p> <p style="text-align: center;">--- < + ---</p>
2. Транзистор типа PNP		
3. Транзистор типа NPN		

Наименование	Обозначение	Отпечатанное обозначение
4. Транзистор типа <i>PNIP</i> с выводом от <i>I</i> -области		<pre> ===== : ρ : --- : I : : *N : : ρ< --- ===== </pre>
5. Многоэмиттерный транзистор типа <i>NPN</i>		<pre> ===== : N : : ρ* --- : <N : : <N : : <N : ===== </pre>
		<pre> ===== : N : --- : *ρ : : N> --- : N> --- : N> --- ===== </pre>

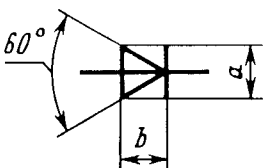

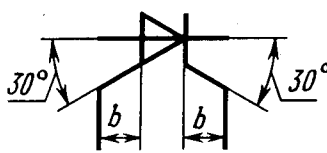
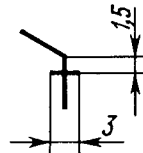
Примечание к пп. 2-5. Звездочкой отмечают вывод базы, знаком „больше” или „меньше” — вывод эмиттера.

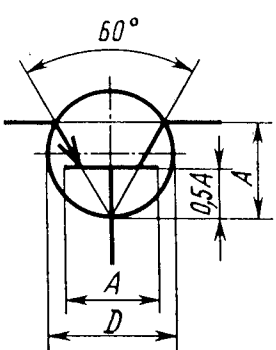
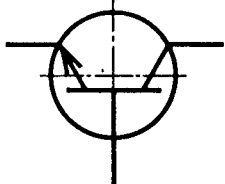
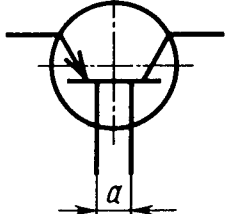
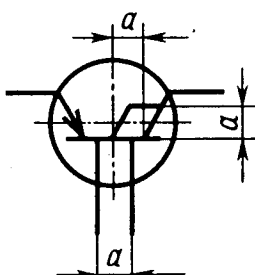
15. Размеры условных графических обозначений полупроводниковых приборов указаны в обязательном приложении.

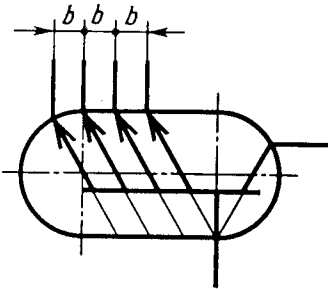
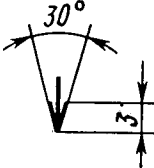
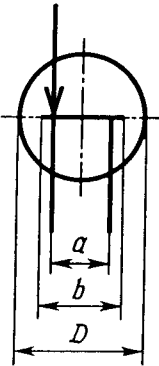
РАЗМЕРЫ УСЛОВНЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ

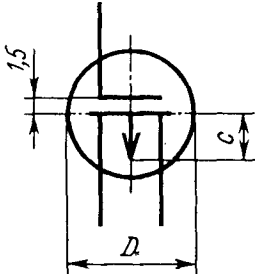
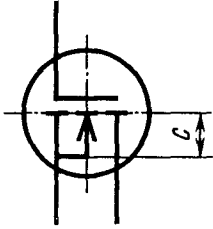
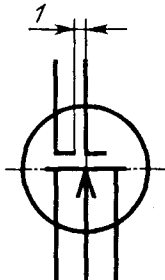
1. Все геометрические элементы условных графических обозначений выполняют линиями той же толщины, что и линии электрической связи.

2. Размеры условных графических обозначений полупроводниковых приборов приведены в таблице.

Наименование	Обозначение	Размеры, мм															
1. Диод		<table border="1"> <tr><td>a</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>b</td><td>4</td><td>5</td></tr> <tr><td>c</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>d</td><td>1,5</td><td>2</td></tr> <tr><td>R</td><td>5</td><td>6</td></tr> </table>	a	5	6	b	4	5	c	5	6	d	1,5	2	R	5	6
a	5	6															
b	4	5															
c	5	6															
d	1,5	2															
R	5	6															
2. Тиристор диодный																	
3. Тиристоры триодный и тетродный	 																

Наименование	Обозначение	Размеры, мм												
9. Транзистор: а) типа <i>PNP</i>		<table border="1" data-bbox="828 292 963 415"> <tr> <td><i>D</i></td> <td>12</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td><i>A</i>*</td> <td>9</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td><i>a</i></td> <td>2,5</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td><i>b</i></td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table> <p data-bbox="839 462 953 508">*$A = \frac{3}{4} D$</p>	<i>D</i>	12	14	<i>A</i> *	9	11	<i>a</i>	2,5	3,5	<i>b</i>	3	4
<i>D</i>	12	14												
<i>A</i> *	9	11												
<i>a</i>	2,5	3,5												
<i>b</i>	3	4												
б) типа <i>NPN</i>														
10. Транзистор с двумя базами														
11. Транзистор типа <i>PNIP</i>														

Наименование	Обозначение	Размеры, мм												
12. Многоэмиттерный транзистор типа <i>NPN</i>														
13. Обозначение затвора (для полевых транзисторов)														
14. Полевой транзистор		<table border="1" data-bbox="816 1255 963 1352"> <tbody> <tr> <td><i>D</i></td> <td>10</td> <td>12</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td><i>a</i></td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td><i>b</i></td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	<i>D</i>	10	12	14	<i>a</i>	5	6	7	<i>b</i>	7	8	9
<i>D</i>	10	12	14											
<i>a</i>	5	6	7											
<i>b</i>	7	8	9											

Наименование	Обозначение	Размеры, мм						
<p>15. Полевой транзистор с изолированным затвором обедненного типа с <i>P</i>-каналом</p>		<table border="1" data-bbox="801 329 934 396"> <tr> <td><i>D</i></td> <td>12</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td><i>C</i></td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>	<i>D</i>	12	14	<i>C</i>	4	5
<i>D</i>	12	14						
<i>C</i>	4	5						
<p>16. Полевой транзистор с внутренним соединением истока и подложки (обогащенный тип; <i>N</i>-канал)</p>								
<p>17. Полевой транзистор с двумя изолированными затворами обедненного типа с <i>N</i>-каналом и с выводом от подложки</p>								

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Государственным комитетом стандартов Совета Министров СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.Р. Верченко, Ю.И. Степанов, Э.Я. Акопян, Ю.П. Широкий,
В.П. Пармешин, И.К. Виноградова

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16.08.73 № 2002
3. **СООТВЕТСТВУЕТ** СВ СЭВ 661-77
4. **ВЗАМЕН** ГОСТ 2.730-68, ГОСТ 2.747-68 в части пп. 33 и 34 таблицы.
5. **ПЕРЕИЗДАНИЕ** (ноябрь 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1980 г., апреле 1987 г. (ИУС № 10-80, 7-87)


Изменение № 3 ГОСТ 2.730—73 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.03.89 № 670

Дата введения 01.01.90

На обложке и первой странице под обозначением стандарта заменить обозначение: (СТ СЭВ 661—77) на (СТ СЭВ 661—88).

Пункт 2. Таблица 1. Графу «Обозначение» дополнить чертежами:

пункт 2. База с двумя выводами: или 

пункт 11. Выводы полупроводниковых приборов, электрически не соединенные

с корпусом:

или


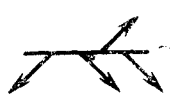


выводы полупроводниковых приборов, электрически соединенные с корпусом


или



пункт 2. Несколько эмиттеров, например, четыре *P*-эмиттера с *N*-областью изложить в новой редакции:





Наименование	Обозначение
несколько <i>P</i> -эмиттеров с <i>N</i> -областью	
несколько <i>N</i> -эмиттеров с <i>P</i> -областью	

Пункт 5. Таблицу 4 дополнить пунктом 9:

Наименование	Обозначение
9. Эффект Шоттки	

Пункт 6. Таблица 5. Пункт 6 изложить в новой редакции; таблицу дополнить пунктами — 8а, 10:


(Продолжение см. с. 380)


Наименование	Обозначение
6. Варикап (диод емкостной)	 или 
8а. Модуль с несколькими одинаковыми диодами с общим катодным и самостоятельными анодными выводами	
10. Диод светоизлучающий	


графа «Обозначение». Для пункта 9 чертеж заменить новым:






Пункт 7. Таблица 6. Чертежи заменить новыми:

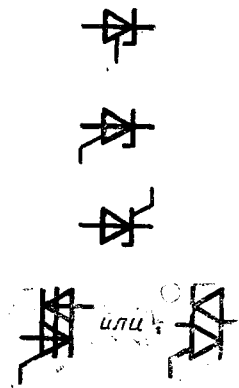
для пункта 2  ;

для пункта 5. Тиристор триодный, запираемый в обратном направлении, с управлением по аноду  ;

пункт 3 дополнить чертежом: или  ;

пункты 6 — 8 изложить в новой редакции:


Наименование	Обозначение
6. Тиристор триодный выключаемый общее обозначение	
запираемый в обратном направлении, с управлением по аноду	
запираемый в обратном направлении, с управлением по катоду	

Наименование	Обозначение
<p>7. Тиристор триодный, проводящий в обратном направлении:</p> <p>общее обозначение</p> <p>с управлением по аноду</p> <p>с управлением по катоду</p> <p>8. Тиристор триодный симметричный (двунаправленный) — триак</p>	

таблицу дополнить примечанием: «Примечание. Допускается обозначение тиристора с управлением по аноду изображать в виде продолжения соответствующей стороны треугольника».

Пункт 8. Таблицу 7 изложить в новой редакции:

Таблица 7

Наименование	Обозначение
<p>1. Транзистор</p> <p>а) типа <i>PNP</i></p> <p>б) типа <i>NPN</i> с выводом от внутреннего экрана</p> <p>2. Транзистор типа <i>NPN</i>, коллектор соединен с корпусом</p> <p>3. Транзистор лавинный типа <i>NPN</i></p>	

Наименование	Обозначение
4. Транзистор однопереходный с <i>N</i> -базой	
5. Транзистор однопереходный с <i>P</i> -базой	
6. Транзистор двухбазовый типа <i>NPN</i>	
7. Транзистор двухбазовый типа <i>PNIP</i> с выводом от <i>i</i> -области	
8. Транзистор двухбазовый типа <i>PNIN</i> с выводом от <i>i</i> -области	
9. Транзистор многоэмиттерный типа <i>NPN</i>	

Примечание. При выполнении схем допускается:

а) выполнять обозначения транзисторов в зеркальном изображении, например,

мер,

б) изображать корпус транзистора.

Пункт 9. Таблицу 8 изложить в новой редакции: —

Таблица 8








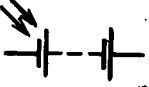
Наименование	Обозначение
1. Транзистор полевой с каналом типа <i>N</i>	
2. Транзистор полевой с каналом типа <i>P</i>	

Наименование	Обозначение
3. Транзистор полевой с изолированным затвором без вывода от подложки:	
а) обогащенного типа с <i>P</i> -каналом	
б) обогащенного типа с <i>N</i> -каналом	
в) обедненного типа с <i>P</i> -каналом	
г) обедненного типа с <i>N</i> -каналом	
4. Транзистор полевой с изолированным затвором обогащенного типа с <i>N</i> -каналом, с внутренним соединением истока и подложки	
5. Транзистор полевой с изолированным затвором с выводом от подложки обогащенного типа с <i>P</i> -каналом	
6. Транзистор полевой с двумя изолированными затворами обедненного типа с <i>P</i> -каналом с выводом от подложки	
7. Транзистор полевой с затвором Шоттки	
8. Транзистор полевой с двумя затворами Шоттки	

Примечание. Допускается изображать корпус транзисторов.

Пункт 10. Таблицу 9 изложить в новой редакции:

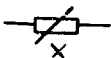
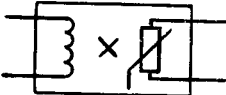
Таблица 9

Наименование	Обозначение
1. Фоторезистор:	
а) общее обозначение	
б) дифференциальный	
2. Фотодиод	
3. Фототиристор	
4. Фототранзистор:	
а) типа <i>PNP</i>	
б) типа <i>NPN</i>	
5. Фотоэлемент	
6. Фотобатарея	

Пункт 11. Таблица 10. Графа «Наименование». Пункт 4. Заменить слова: «Оптрон диодный с усилителем» на «Прибор оптоэлектронный с фотодиодом и усилителем»

(Продолжение см. с. 385)

Пункт 12. Таблицу 11 дополнить пунктами — 2, 3:

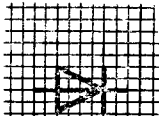
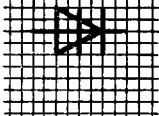
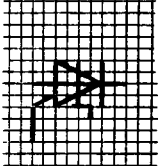
Наименование	Обозначение
2. Резистор магниточувствительный	
3. Магнитный разветвитель	

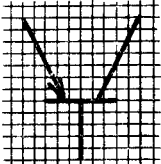
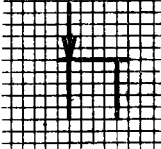
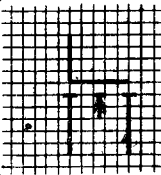
Пункт 15 изложить в новой редакции: «Размеры условных графических обозначений полупроводниковых приборов указаны в приложении 1. Размеры (в модульной сетке) основных условных графических обозначений даны в приложении 2».

Стандарт дополнить приложением — 2:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Размеры (в модульной сетке) основных условных графических обозначений

Наименование	Обозначение
1. Диод	
2. Тиристор диодный	
3. Тиристор триодный	

Наименование	Обозначение
4. Транзистор	
5. Транзистор полевой	
6. Транзистор полевой с изолированным затвором	

(ИУС № 6 1989 г.)

Издание № 4 ГОСТ 2.730—73 Единая система конструкторской документации.
Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и
метрологии СССР от 15.07.91 № 1255

Дата введения 01.01.92

Пункт 15 изложить в новой редакции: «Размеры (в модульной сетке) ос-
новных условных графических обозначений даны в приложении 2».
Приложение 1 исключить.

(ИУС № 10 1991 г.)

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ГОСТ 2.723-68	Обозначения условные графические в схемах. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители	3
ГОСТ 2.725-68	Обозначения условные графические в схемах. Устройства коммутрующие	22
ГОСТ 2.726-68	Обозначения условные графические в схемах. Токосъемники	27
ГОСТ 2.727-68	Обозначения условные графические в схемах. Разрядники; предохранители	28
ГОСТ 2.728-74	Обозначения условные графические в схемах. Резисторы; конденсаторы	35
ГОСТ 2.729-68	Обозначения условные графические в схемах. Приборы электроизмерительные	57
ГОСТ 2.730-73	Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые	67

Редактор *Р.Г. Говердовская*
Технический редактор *М.И. Максимова*
Корректор *Е.А. Богачкова*

Сдано в наб. 05.01.88 Подп. в печ. 06.04.88 6,0 усл. п. л. 7,3 усл. кр.-отт.
3,78 уч.-изд. л. Тир. 30000 Цена 20 коп.

Ордена „Знак Почета” Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер. 3

Набрано в Издательстве стандартов на НПУ
Вильнюсская типография Издательства стандартов,
ул. Даряус и Гирено, 39. Зак. 1340